

HALAMAN PENGESAHAN

LEMBAR 1

Judul : PEMBUATAN DAN KARAKTERISASI SILIKON AMORF
TERHIDROGENISASI Ca-Si: HD

Nama : ARIS HARYADI

NIM : J 401 91 0642

Jurusan : Fisika

Telah lulus ujian sarjana pada tanggal 28 Januari 1997.



Semarang, Januari 1997

Panitia Penguji Ujian Sarjana

Jurusan Fisika

Ketua

Drs. Nasio Aemoro Hadi, Msi
NIP. 131 832 256

Dra. Soenarto
NIP. 130 205 450



HALAMAN PENGESAHAN

LEMBAR 2

Judul : PEMBUATAN DAN KARAKTERISASI SILIKON AMORF
TERHIDROGENISASI Ca-Si:HD

Nama : ARIS HARYADI

NIM : J 401 91 0642

Jurusan : Fisika

Telah selesai dan layak untuk mengikuti ujian sarjana.



Semarang, Januari 1997

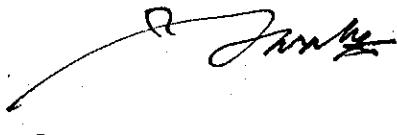
Dosen Pembimbing II


Drs. Agus Santoso
NIP. 330 001 934

Dosen Pembimbing III


Drs. Rahmat Gernowo
NIP. 131 087 425

Dosen Pembimbing I


Drs. Wahyu Setia Budi, MS
NIP. 131 459 438

MOTTO

Sesungguhnya Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu pengetahuan diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

(Q.S. Al Mujaadilah : 11)



Dipersembahkan kepada :

*Bapak-Ibu, Mas Nur, Agus dan Hari
atas bantuan dan doa yang tulus*

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis senantiasa panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga dapat mewujudkan penulisan Tugas Akhir yang berjudul : **Pembuatan Dan Karakterisasi Silikon Amorf Terhidrogenisasi Ca-Si:HD**, yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang fisika pada jurusan Fisika F-MIPA Universitas Diponegoro Semarang.

Namun demikian, terwujudnya tugas akhir ini penulis tidak bekerja sendiri tetapi melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu sudah pada tempatnya lah jika penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Ka. Pus. PPNY-BATAN Yogyakarta.
3. Ibu Dekan Fakultas Matematik Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Ketua Jurusan Fisika Fakultas Matematik Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro.
5. Bapak Drs. Wahyu Setia Budi, MS. selaku pembimbing I.
6. Bapak Drs. Agus Santoso selaku pembimbing II.
7. Bapak Drs. Rahmat Gernowo selaku pembimbing III.
8. Bapak-Ibu seluruh staf dosen jurusan Fisika F-MIPA.
9. Bapak Ir. BA. Tjipto Prayitno, Bapak Sumarmo, Bapak Irianto dan Bapak Muji atas bantuan tenaga dan

bimbingannya.

10. Rekan Adiyanto, Udi Harmoko dan rekan-rekan fisika "91.
11. Dan kepada semua pihak yang telah membantu dan tidak mungkin untuk kami sebutkan satu persatu.

Penulis berharap apa yang telah disusun ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang fisika material bidang semikonduktor dan ilmu fisika secara umum. Atau minimal dapat memberikan sedikit masukan tentang perkembangan silikon amorf.

Penulis menyadari bahwa dalam tugas akhir ini, baik struktur maupun isinya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis dengan lapang dada menerima saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan dimasa mendatang.

Semarang, September 1996

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Motto dan Persembahan.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar isi	vii
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Tabel.....	xi
Abstrak	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	3
1.3. Batasan Masalah	4
1.4. Tujuan	4
1.5. Kegunaan Penelitian	5
1.6. Sistematika Penulisan Skripsi.....	5
BAB II. DASAR TEORI	8
2.1. Struktur Padatan Amorf	8
2.1.1. Model Pita Energi Padatan Amorf	11
2.2. Silikon Amorf	13
2.3. Silikon Amorf Terhidrogenisasi	15
2.4. Deposisi Lapisan Tipis	17
2.5. Pertumbuhan Lapisan Tipis Pada substrat	18

2.6.	Sifat-sifat Optik	21
2.6.1.	Absorbsi	21
2.7.	Penganilan (Annealling)	26
2.7.1.	Pemulihan	26
2.7.2.	Rekristalisasi	27
2.7.3.	Pertumbuhan Butir	28
2.7.4.	Pengaruh Anil	28
 BAB III. TATA KERJA		 30
3.1.	Bahan dan Alat	30
3.1.1.	Bahan	30
3.1.2.	Alat	30
3.2.	Mekanisme Kerja	32
 BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN		 43
4.1.	Hasil	43
4.2.	Pembahasan	44
 BAB V. KESIMPULAN		 52
5.1.	Kesimpulan	52
5.2.	Saran	53
 Daftar Pustaka		
 Lampiran		

DAFTAR GAMBAR

	halaman
(2-1). Skema Pembentukan Amorf	9
(2-2). a. Struktur Padatan Kristal b. Struktur Padatan Amorf	10
(2-3). Model Pita Pada Semikonduktor Amorf	11
(2-4). a. Struktur Silikon Amorf b. Struktur Silikon Amorf Terhidrogenisasi (a-Si:H)	16
(2-5). a. Jarak Difusi Permukaan Pendek b. Jarak Difusi Permukaan panjang	19
(2-6). Proses Serapan Optik	22
(2-7). Koefisien Serapan Sebagai Fungsi $h\nu$	22
(2-8). Spektra Absorbsi Elektronik (a) a-Si dan c-Si, (b) a-Ge dan c-Ge	25
(2-9). a. Susunan Acak Dislokasi Sisi Yang Sejajar b. Penyebarisan Dislokasi Membentuk Dinding	27
(2-10) Pertumbuhan Butir	28
(2-11) Efek Anil (a). Lapisan GD-Anoda (b). Lapisan GD-Katoda	29
(3-1). Skema Mekanisme Kerja	33
(3-2). Sistem Vakum Ruang Evaporasi	34
(3-3). Rangkaian Alat Secara Lengkap	35
(3-4). Bentuk Evaporan Pada Lapisan Tipis	37
(3-6). Skema Spektrofotometer UV-VIS	39
(3-7). Skema Spektrofotometer Inframerah	41

(3-8). Skema Anil	42.
(4-1). Grafik Suhu Anil vs Absorbsi	45
(4-2). Spektra Serapan Inframerah	49
(4-3). Pola difraksi sinar X	51



DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1 : Hubungan Si dan Ge dengan tetangga terdekat.	10
Tabel 2.2 : Perbandingan a-Si dan a-Si:H.....	16

